## 练习四

## 一. 思考题

- 1. 空穴导电和电子导电有何共同点和不同点?
- 2. 简述 PN 结的形成机理及导电特性。
- 3. 稳压二极管主要工作在反向击穿区以得到稳定的电压,普通二极管是否也可以工作 在反向击穿区以达到稳压的目的?
- 4. 为什么二极管在使用时一定要接限流电阻?
- 5. 为什么功率二极管电路的分析计算一般采用折线模型? 二极管的折线模型可以用哪些理想元件表示?
- 6. 简述确定二极管的工作状态的方法。先假定二极管导通行不行?
- 7. 晶体三极管是由两个 PN 结构成的。能否用两个二极管组成三极管?说明原因。
- 8. 如何理解"在晶体管中,两种载流子都参与导电"?若晶体管中的少数载流子可以 忽略不计,则晶体管能否作为单极型半导体器件?
- 9. 简述当晶体管处于放大、截止和饱和的不同状态时,晶体管内部的载流子运动情况。
- 10. 晶体管具有电流放大作用的内部条件和外部条件各是什么?若将正文中图 4-28 所示电路中晶体管的发射极和集电极接反了会出现什么情况?
- 11. 如何理解"晶体管饱和时,发射结和集电结都是正向偏置,但流过集电结的仍是反向电流"?
- 12. 晶体管饱和时的集电结正向偏置和二极管 PN 结的正向偏置有何不同?
- 13. 简述判断晶体管工作状态的方法及步骤。
- 14. 试作出一个 PNP 型晶体三极管的应用电路, 使晶体管满足放大条件。
- 15. 简述增强型 MOS 管的导通机理和关断机理。使 N 沟道增强型 MOS 管导通的栅源 电压  $U_{GS}$  (即开启电压  $V_{GS(th)}$  ) 应为何极性?
- 16. 简要说明场效应管称为单极型晶体管的原因。若场效应管中的少数载流子不能忽略,则场效应管是否还是单极型半导体器件?
- 17. MOS 管的源极和漏极在原理上有无区别?若将正文中图 4-28 所示 MOS 管电路中电源极性接反了会出现什么情况?

## 二、计算题

1. 有两个稳压管  $D_{Z1}$  和  $D_{Z2}$  ,其稳定电压分别为 5.5V 和 8.5V,正向压降都是 0.5V。如果要得到 0.5V,3V,5V,6V,9V 和 14V 几种稳定电压,稳压电路(包括稳压管和

限流电阻)应该如何联接?画出各个电路图。

2. 判断图 4-1 所示各电路中二极管的工作状态,并计算电流  $I_D$  和电压  $U_{AB}$  的值。设各二极管的导通压降均为  $U_{\gamma}$ =0.7 伏。

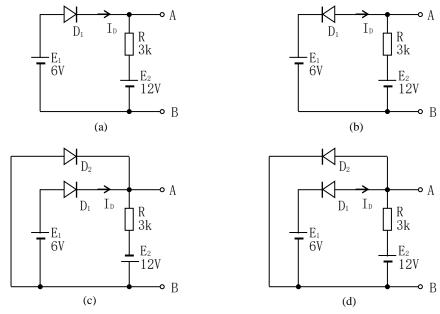
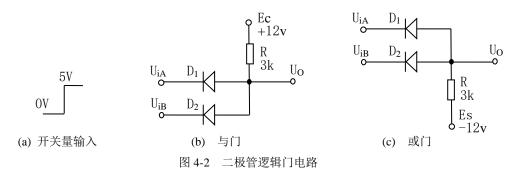
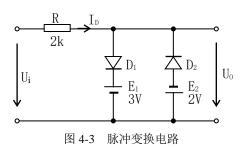


图 4-1 二极管电路

3. 图 4-2 所示电路是数字电路中的"与门"和"或门"电路。电路的输入电压只能是 0 伏或 5 伏 (这种输入信号常称为"开关量")。设各二极管均为理想二极管。计算电路在不同输入组合时,各二极管的工作状态及输出电压  $U_0$  的值。取  $U_{\gamma}$ =0.7 伏。

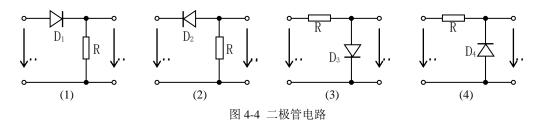


4. 图 4-3 所示的双向限幅电路,可以把输出电压限制在指定范围内。设图中各二极管均为理想二极管。当输入电压分别为-3 伏和+5 伏时,判断各二极管的工作状态,并计算电流 I<sub>D</sub> 和电压 U<sub>O</sub>的

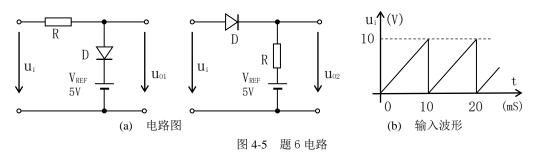


值。

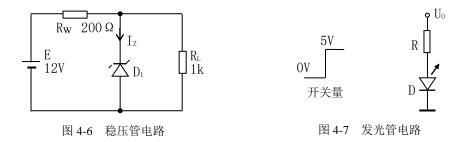
5. 图 4-4 所示各电路中,各二极管均为理想二极管,输入电压  $\mathbf{u}_{i=7.07}$  Sin(500t)伏。画 出各电路的输出电压波形。



6. 图 4-5(a)所示电路图中,D 均为理想二极管,输入信号  $u_i$  为图 4-5(b)所示锯齿波。作出输出电压  $u_{01}$  和  $u_{02}$  的波形。



7. 图 4-6 所示电路中,稳压管  $D_Z$  的稳定电压  $V_{Z=9}$  伏,求稳压管中的电流  $I_Z$  。

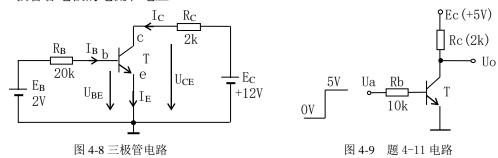


- 8. 常用发光二极管来显示电路的状态。图 4-7 所示电路中,发光二极管  $D_Z$  的正向导通 压降  $V_{\gamma}$ =2 伏, $U_O$  为开关量。当  $U_O$ =5 伏时,要求发光二极管的导通电流为 5 毫安 以显示  $U_O$  的高电位状态,求电阻 R 的阻值。
- 9. 某放大电路中有两个晶体管,测得它们管脚的电位(对"地")分别如下表所列:

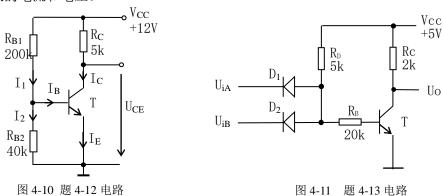
晶体管 A				_	晶体管 B				
管脚	1	2	3		管脚	1	2	3	
电位(V)	4	3.4	9		电位(V)	-6	-2.5	-2	

试判别各晶体管的电极,并说明是 NPN 型还是 PNP 型晶体管?

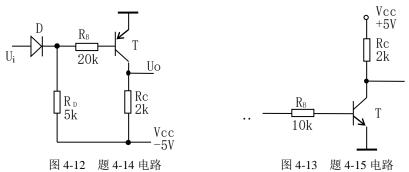
10 图 4-8 所示三极管电路中,若三极管的 β =60, VBES=0.7 伏, VCES=0 伏。计算三极管各电极的电流和电压。



- 11. 图 4-9 所示电路中,若三极管的 β =50, VBES=0.7 伏, VCES=0 伏。若输入电压只能是 0 伏或 5 伏。计算电路在不同输入电压时,三极管的工作状态及各电极的电流和电压。
- 图 4-10 所示电路中,若晶体管的  $\beta$  =40,VBES=0.7 伏,VCES=0 伏。计算晶体管 各电极的电流和电压。



- 13. 图 4-11 所示电路中,若晶体管的 β =40, VBES=0.5 伏, VCES=0 伏, D 是理想二极管, UiA=0 伏, UiB=3.5 伏。判断各半导体器件的工作状态并确定 UO 的值。
- 14. 图 4-12 所示电路中,若晶体管 T 的  $\beta$  =40,VBES=-0.5 伏,VCES=0 伏,D 是理想 二极管,Ui=-3.5 伏。判断各半导体器件的工作状态并确定 UO 的值。
- **业**. 图 4-13 所示电路中,晶体管的β=50, VBES=0.7 伏, VCES=0 伏, 输入电压 ui=1.4Sin(500t)伏。画出输出电压 UO 的波形。



 $^{16}$  图 4-14 所示电路中,晶体管的  $\beta$  =50, $V_{BES}$ =0.5 伏, $V_{CES}$ =0 伏,输入电压为图示三角波。画出输出电压  $U_{O}$  的波形。

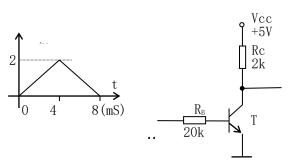


图 4-14 题 4-16 电路

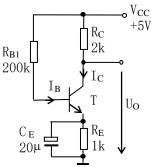


图 4-15 题 4-17 电路

- 17. 图 4-15 所示电路中,若晶体管的  $\beta$  =40, $V_{BES}$ =0.7 伏, $V_{CES}$ =0 伏。计算晶体管各电极的电流和电压,并确定输出电压  $U_0$  的值。
- 18. 图 4-16 所示电路中,晶体管的 β =50, $V_{BES}$ =0.5 伏, $V_{CES}$ =0 伏,输入电压  $u_i$ =4Sin(100t)伏。画出输出电压  $U_0$ 的波形。

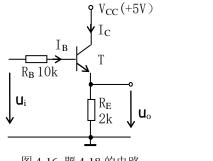


图 4-16 题 4-18 的电路

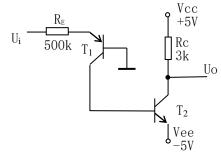


图 4-17 题 4-19 的电路

- 19. 图 4-17 所示电路中,若晶体管 T<sub>1</sub> 为β=40, V<sub>BES</sub>=-0.5V, V<sub>CES</sub>=0V; T<sub>2</sub> 为β=50, V<sub>BES</sub>=0.7V, V<sub>CES</sub>=0V; 输入电压 U<sub>i</sub>=1 伏。计算输出电压 U<sub>o</sub> 的值。
- 20. 图 4-18 所示电路中, N 沟道耗尽型 MOS 管 的 V<sub>P</sub>=-4V , I<sub>DSS</sub>=1mA。 计算电路的输出电压 U<sub>O</sub> 的值。

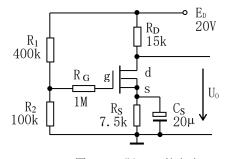


图 4-18 题 4-20 的电路